

**ПРОТОКОЛ № 19/2018**  
Заседания Конкурсной Комиссии  
на замещение вакантных должностей научных работников  
Федерального государственного автономного научного учреждения  
Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники  
имени В.Г. Мокерова Российской академии наук

г. Москва

28 сентября 2018 г.

**Присутствовали:**

Председатель комиссии	- доктор технических наук, профессор, директор ИСВЧПЭ РАН С.А.Гамкрелидзе
Заместитель председателя комиссии	- кандидат физико-математических наук, доцент заместитель директора по научной работе ИСВЧПЭ РАН Д.С. Пономарев
Секретарь комиссии	- кандидат физико-математических наук, ученый секретарь ИСВЧПЭ РАН Р.А. Хабибуллин
Члены комиссии:	- кандидат технических наук, председатель Профкома ИСВЧПЭ РАН А.Ю. Павлов - доктор технических наук, профессор, зам. ген. директора по научной работе ОАО «НПП «Пульсар» Ю.В. Колковский - член-корреспондент РАН, врио директора ФТИАН В.Ф. Лукичев - доктор технических наук, профессор, зам. директора НИИВТ им С.А. Векшинского С.Б. Нестеров

Всего: 7 человек из 7 членов Конкурсной комиссии.

**Повестка дня:** Проведение конкурса на замещение вакантной должности научного сотрудника лаборатории № 106 «Лаборатория исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малошумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС на их основе».

**Слушали:**

1. Председатель Конкурсной комиссии ИСВЧПЭ РАН д.т.н., профессор С.А. Гамкрелидзе проинформировал участников заседания о том, в Конкурсную комиссию ИСВЧПЭ РАН поступило заявление и комплект документов, необходимых для проведения конкурса, от Томоша Константина Николаевича для избрания его на должность научного сотрудника «Лаборатории исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малошумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС на их основе». Директор зачитал характеристику Томоша К.Н., подписанную заведующим лабораторией №106 Павловым А.Ю. В ней, в частности отмечается, что в процессе работы в ИСВЧПЭ РАН Томош К.Н. выполнял различные исследовательские задачи как экспериментального, так и теоретического характера: проводил работы, связанные с

оптимизацией плазмохимических процессов на имеющемся плазмохимическом оборудовании, которые были внедрены в технологический цикл изготовления СВЧ приборов на полупроводниках группы АЗВ5. Принимал участие в изготовлении квантово-каскадного лазера и разработке критических процессов, влияющих на основные параметры СВЧ приборов. Томош К.Н. участвовал в выполнении научно-исследовательских работ ИСВЧПЭ РАН.

Томош К.Н. является соавтором более 7 статей в ведущих отечественных научных журналах. Результаты исследований неоднократно представлялись на отечественных научных конференциях и семинарах. В процессе работы в ИСВЧПЭ РАН он проявил себя как квалифицированный специалист в области технологии плазмохимии, способный к самостоятельной научно-исследовательской работе.

Документы удовлетворяют квалификационным характеристикам.

2. Председатель Конкурсной комиссии ИСВЧПЭ РАН д.т.н., профессор С.А. Гамкрелидзе проинформировал участников заседания о том, в Конкурсную комиссию ИСВЧПЭ РАН поступило резюме для прохождения конкурса от Доброносовой Алины Александровны 1994 г.р. для избрания по конкурсу на должность научного сотрудника «Лаборатории исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малошумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС на их основе».

Однако документы претендента не удовлетворяют квалификационным характеристикам, предъявляемым по соответствующей должности, а также в комиссию представлен не полный пакет документов, в связи с этим членами Конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию претендента Доброносовой А.А.

3. Председатель Конкурсной комиссии ИСВЧПЭ РАН д.т.н., профессор С.А. Гамкрелидзе проинформировал участников заседания о том, в Конкурсную комиссию ИСВЧПЭ РАН поступило резюме для прохождения конкурса от Грунского Дмитрия Игоревича 1970 г.р. для избрания по конкурсу на должность научного сотрудника «Лаборатории исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малошумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС на их основе».

Однако документы претендента не удовлетворяют квалификационным характеристикам, предъявляемым по соответствующей должности, а также в комиссию представлен не полный пакет документов, в связи с этим членами Конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию претендента Доброносова А.А.

Больше заявок на занятие этой должности в Конкурсную комиссию не поступало.

### **Постановили:**

#### **По 1-му пункту повестки дня:**

1) Согласно п. 11 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 в продлении срока рассмотрения заявок для проведения собеседования с претендентом необходимости нет.

2) Признать конкурс на замещение вакантной должности научного сотрудника лаборатории № 106 «Лаборатории исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малошумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС на их основе» состоявшимся в объявленные сроки.

3) Согласно п. 12 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 по итогам рассмотрения заявки Конкурсная комиссия составила рейтинг претендента на основании балльной оценки, выставленной членами Конкурсной комиссии претенденту,

исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных прикреплённых к заявке материалах, которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента, Конкурсная комиссия приняла решение избрать на должность:

- научного сотрудника «Лаборатории исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малошумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС на их основе».

– Томоша Константина Николаевича.

Председатель Конкурсной комиссии  
д.т.н., профессор  
Секретарь Конкурсной комиссии  
к.ф.-м.н.

«28» сентября 2018 г.



С.А. Гамкредидзе

Р.А. Хабибуллин